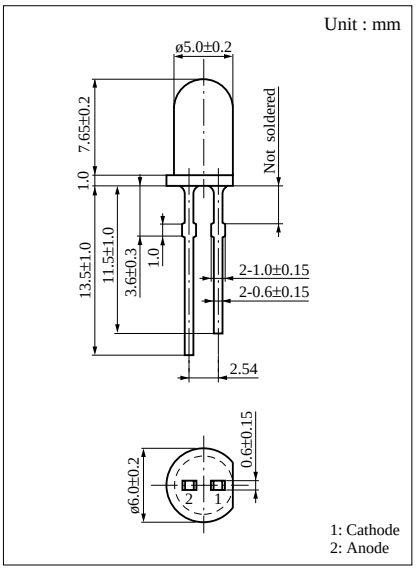
LNA2903L

GaAs Infrared Light Emitting Diode

For optical control systems



Features

- High-power output, high-efficiency : I_e = 9 mW/sr (min.)
- Emitted light spectrum suited for silicon photodetectors
- Good radiant power output linearity with respect to input current
- Wide directivity : θ = 20 deg. (typ.)
- Transparent epoxy resin package

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25˚C)

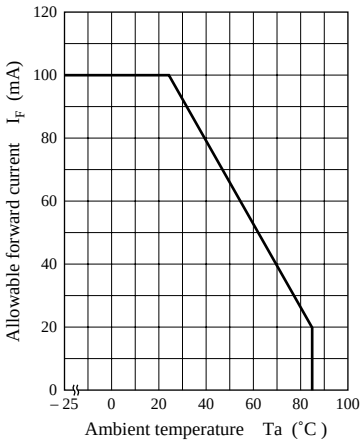
Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Power dissipation	P_D	160	mW
Forward current (DC)	I_F	100	mA
Pulse forward current	I_{FP}*	1.5	A
Reverse voltage (DC)	V_R	3	V
Operating ambient temperature	T_{opr}	–25 to +85	˚C
Storage temperature	T_{stg}	– 40 to+100	˚C

* f = 100 Hz, Duty cycle = 0.1 %

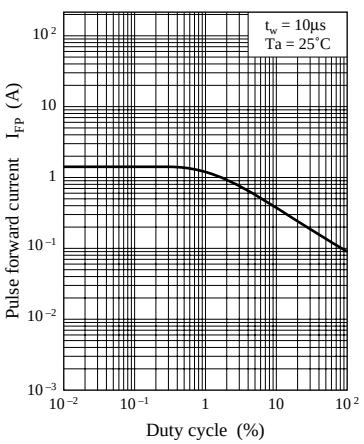
Electro-Optical Characteristics (Ta = 25˚C)

Parameter	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
Radiant intensity at center	I_e	I_F = 50mA	9			mW/sr
Peak emission wavelength	λ_P	I_F = 50mA		950		nm
Spectral half band width	$\Delta\lambda$	I_F = 50mA		50		nm
Forward voltage (DC)	V_F	I_F = 100mA		1.4	1.6	V
Reverse current (DC)	I_R	V_R = 3V			10	μA
Capacitance between pins	C_t	V_R = 0V, f = 1MHz		35		pF
Half-power angle	θ	The angle in which radiant intencity is 50%		25		deg.

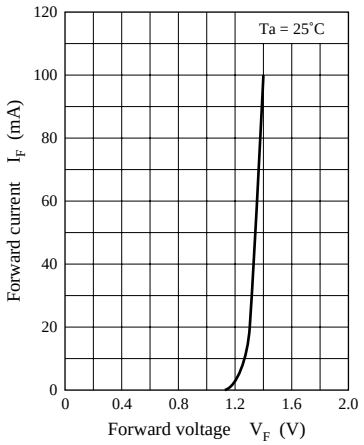
I_F — Ta



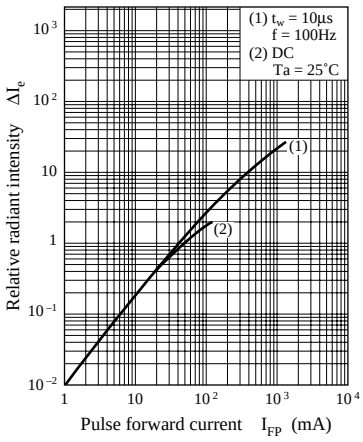
I_{FP} — Duty cycle



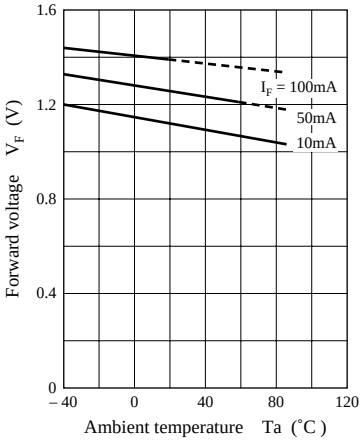
I_F — V_F



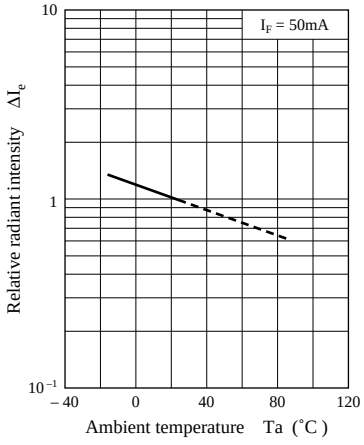
ΔI_e — I_{FP}



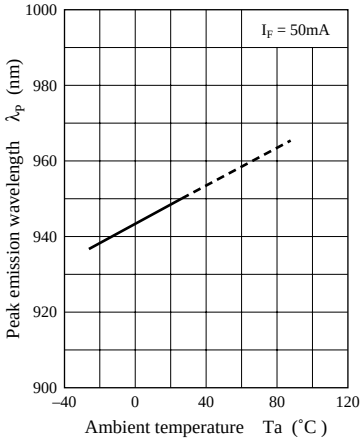
V_F — Ta



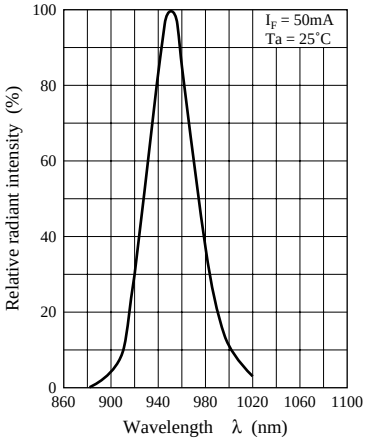
ΔI_e — Ta



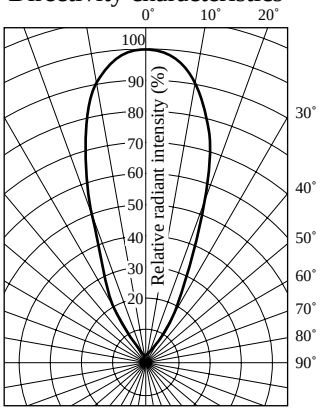
λ_P — Ta



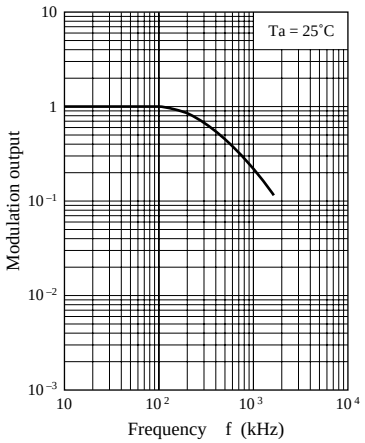
Spectral characteristics



Directivity characteristics



Frequency characteristics



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709